

# SS8550

## Кремниевый биполярный р-п-р транзистор.

### ОСОБЕННОСТИ:

- Высокий ток
- Низкое напряжение

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Общего назначения коммутации и усиления.

### ОПИСАНИЕ

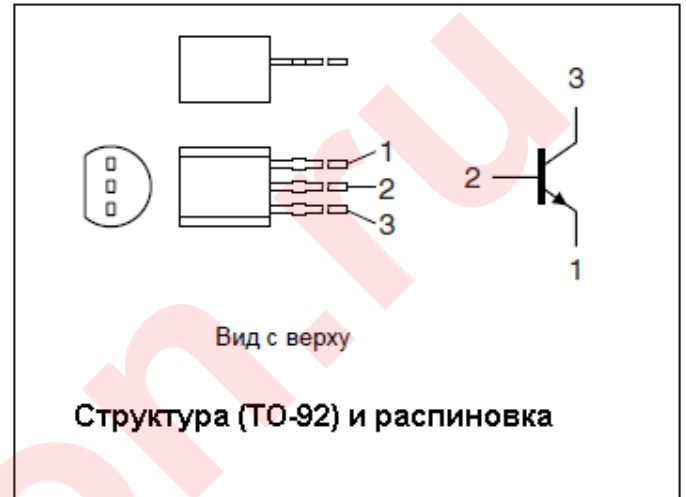
- Комплиментарная пара SS8050.

### Механические данные

- Корпус: ТО-92, пластик
- Вывода: пайка в MIL-STD-202, методика 208

### РАСПИНОВКА

Вывод	ОПИСАНИЕ
1	коллектор
2	база
3	эмиттер



**Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации при Токр. среды = 25 °С.**

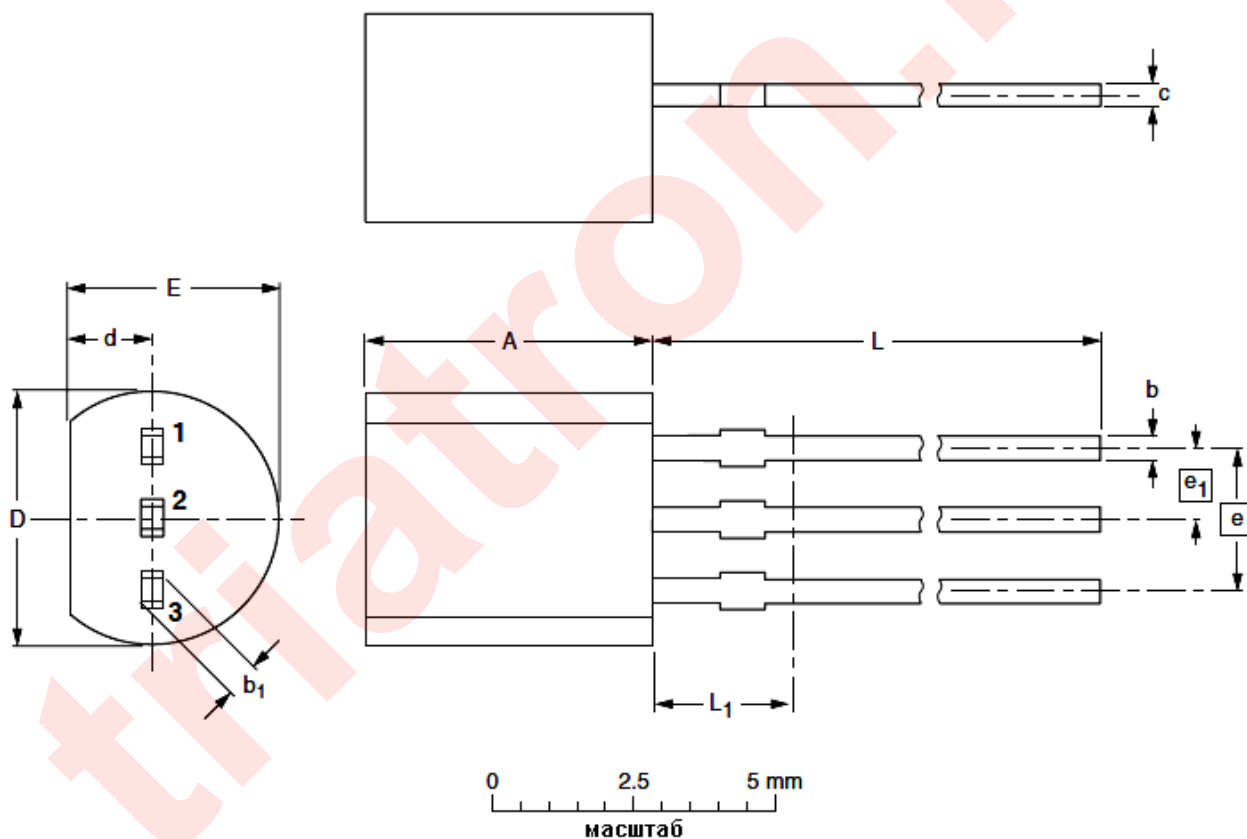
Обозначение	Параметр	Значение	Единицы измерения
Uкб max	Напряжение коллектор-база	-40	В
Uкэ max	Напряжение коллектор-эмиттер	-25	В
Uэб max	Напряжение эмиттер-база	-6	В
Iк max	Постоянный ток коллектора	-1.5	А
Pк max	Рассеиваемая мощность коллектора	1	Вт
Tj	Температура перехода	150	°С
Tamb	Диапазон рабочих температур	-65 до 150	°С
Tstg	Диапазон температур хранения	-65 до 150	°С

## Электрические характеристики при Токр. среды = 25 °С.

Обозначение	Параметр	Условия испытания	Мин.	Тип.	Макс	Единицы измерения
Uкб проб.	Коллектор-база напряжение пробоя	$I_K=-100\text{мкА}, I_3=0$	-40			В
Uкэ проб.	Коллектор-эмиттер напряжение пробоя	$I_K=-2\text{мА}, I_B=0$	-25			В
Uэб проб.	Эмиттер-база напряжение пробоя	$I_3=-100\text{мкА}, I_K=0$	-6			В
Iкбо	Коллектор-база ток отсечки	$U_{кб}=-35\text{В}, I_3=0$			-100	нА
Iэбо	Эмиттер-база ток отсечки	$U_{эб}=-6\text{В}, I_K=0$			-100	нА
$h_{21э}$	Статический коэффициент передачи тока	$I_K=-5\text{ мА}, U_{кэ}=-1.0\text{В}$ $I_K=-100\text{ мА}, U_{кэ}=-1.0\text{В}$ $I_K=-800\text{ мА}, U_{кэ}=-1.0\text{В}$	45 85 40	170 160 80	300	
Uкэ(нас)	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$I_K=-800\text{мА}, I_B=-80\text{мА}$		-0.28	-0.5	В
Uбэ(нас)	Напряжение насыщения база-эмиттер	$I_K=-800\text{мА}, I_B=-80\text{мА}$		-0.98	-1.2	В
Uбэ(вкл.)	Напряжение включения база-эмиттер	$I_K=-10\text{мА}, U_{кэ}=-1\text{В}$		-0.66	-1.0	В
Ск	Емкость коллекторного перехода	$U_{кб}=-10\text{В}, I_3=0, f=1\text{МГц}$		15		пФ
fгр.	Граничная частота коэф. передачи тока	$U_{кэ}=-10\text{В}, I_K=-50\text{мА}, f=100\text{МГц}$	100	200		МГц

Пластиковый корпус, 3 вывода

ТО-92



Размеры (мм, оригинальный размер)

Ед. измерения	A	b	b <sub>1</sub>	c	D	d	E	e	e <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub> <sup>(1)</sup> max.
мм	5.2 5.0	0.48 0.40	0.66 0.55	0.45 0.38	4.8 4.4	1.7 1.4	4.2 3.6	2.54	1.27	14.5 12.7	2.5

## Typical Performance Characteristics

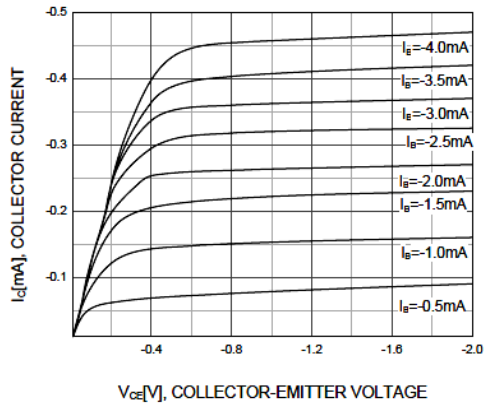


Figure 1. Static Characteristic

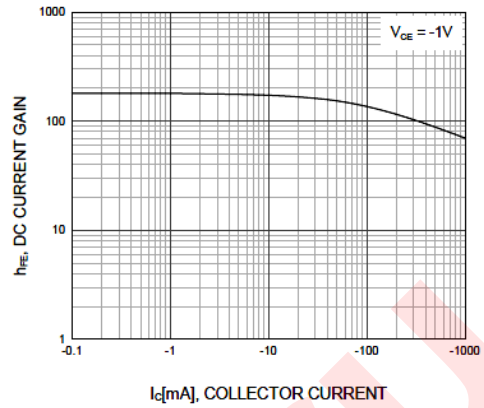


Figure 2. DC current Gain

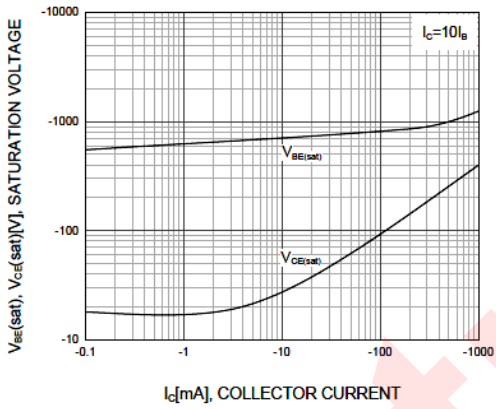


Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage  
Collector-Emitter Saturation Voltage

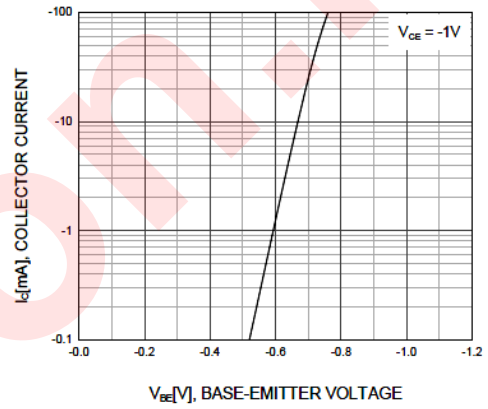


Figure 4. Base-Emitter On Voltage

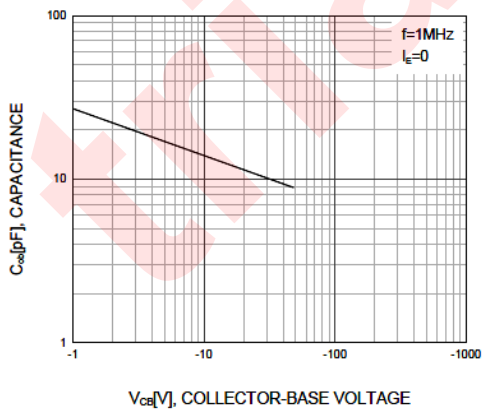


Figure 5. Collector Output Capacitance

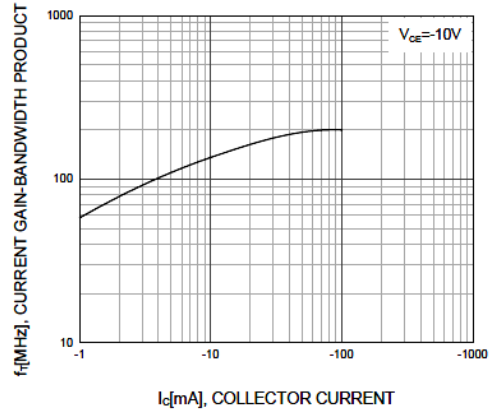


Figure 6. Current Gain Bandwidth Product